	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS021D(单胞)	文件编号	临时
	肖特基二极管	版本号	18-B2-05
		页码	1/2

1 主要用途及主要特点

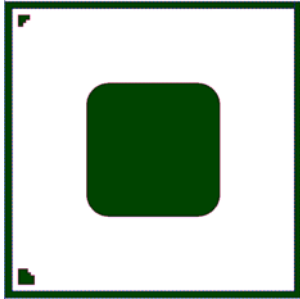
1.1 主要用途

用 W1XS021D 封装的成品管主要用于通讯设备保护线圈与 ESD 保护。

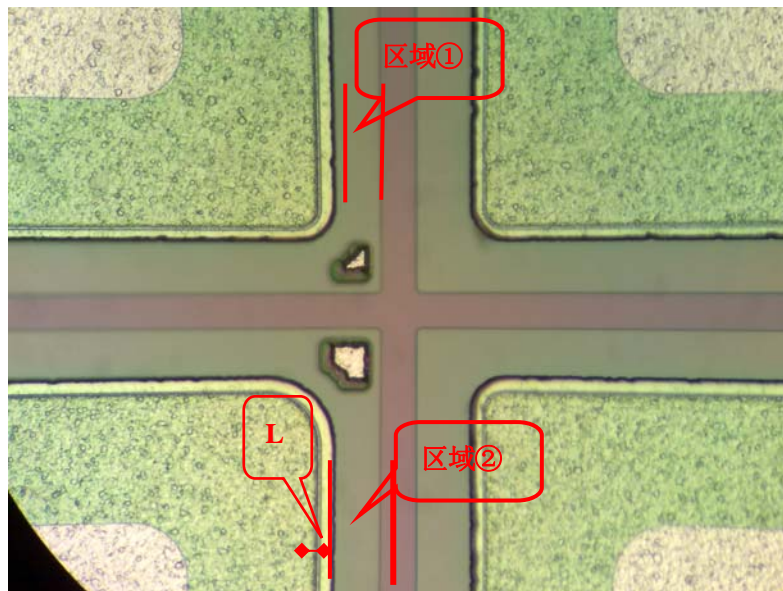
1.2 主要特点

- 低正向压降
- 低反向漏电流
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸		0.40 mm×0.40 mm	
			15.75 mil×15.75 mil	
	芯片厚度 (μm) (推荐)		≤170	
	划片道*尺寸 (μm)		40	
	键合区面积 (μm ²)	正面	150×150	
	正面电极 (阳极)	金属	铝	
		厚度 (μm)	5.0± 1.0	
	背面电极 (阴极) (推荐)	表层金属	金	银
	装片要求 (推荐)		共晶	低温共晶
	硅片直径 (mm)		Φ 125	
	键合要求 (推荐)		1 根 Φ 32μm 铜线	

* 划片道位置示意图:




备注: 区域①为划片刀走刀区域, 划片时应在两条参考线中间; 区域②为划片道区域, 宽度为 40 μm; 区域②两侧各保留 18 μm 即判定为合格。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
电话: (0510) 86851182

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS021D(单胞)	文件编号	临时
	肖特基二极管	版本号	18-B2-05
		页码	2/2

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	40	V	推荐封装形式: SOD-323 推荐成品型号: MBRX02540
正向电流	I_D	0.25	A	
结温	T_j	110	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R=100\ \mu\text{A}$	40	—	—	V
反向电流	I_R	$V_R=40\text{V}$	—	—	100	μA
正向电压	V_F	$I_F=250\text{mA}$	—	—	550	mV
总电容	C_{tot}	$V_R=4\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	10	—	pF

3.3 典型特性曲线

暂无

注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532